

InGaAs фотодетекторный чип 1740 нм, 300 мкм — техническое описание

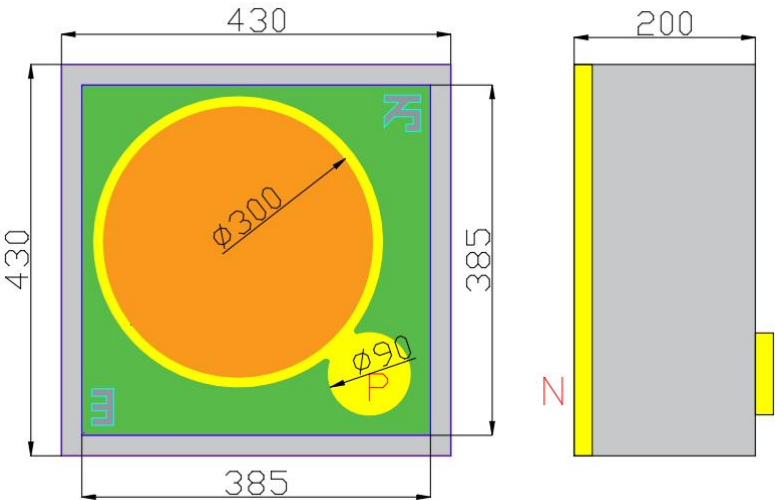
P/N : WIR3-300

Область применения

Высокая чувствительность
Низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–1740 нм

Структура

InGaAs/InP PIN-чип. Р-электрод (анод): золото.
N-электрод (катод): золото.



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Примечания
Активная область	-	300	-	мкм	
Ширина чипа	-	430	-	мкм	
Длина чипа	-	430	-	мкм	
Высота чипа	180	200	220	мкм	
Размер контактной площадки	85	90	95	мкм	

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Темновой ток	Id	Vr=-5V	--	0.2	1	нА
Емкость	Cp	Vr=-5V	-	7	10	пФ
Напряжение обратного смещения	Vbr	Ir=-10μA	20	35	--	В
Чувствительность	R	Vr=0V,@1654 nm	0.95	1	1.05	А/Вт
Рабочий диапазон длин волн	λ		1100	1650	1740	нм

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Рабочая температура	от -40 °C до +85 °C
Температура хранения	от -55 °C до +125 °C
Прямой ток	10 мА